

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника, кандидат
в лаборатории полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей
Вакансия VAC_59719

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физики и технологии высокоэффективных полупроводниковых лазеров

Трудовая деятельность

Участие в научных исследованиях по разработке высокоэффективных полупроводниковых лазеров в составе коллектива лаборатории, включая:

- моделирование полупроводниковых лазерных гетероструктур с использованием вычислительных пакетов SILVACO, Comsol Multiphysics;
- измерения выходных электрических и оптических характеристик лазерных диодов, включая спектры излучения, ватт-амперные характеристики в импульсном и непрерывном режимах, расходимость излучения;
- фото- и электро-люминесцентные исследования гетероструктур;
- руководство и обучение студентов, лаборантов и стажеров-исследователей фундаментальным и прикладным навыкам разработки и исследованию гетероструктур и лазерных диодов на их основе.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя заведующим лабораторией.

Особенности трудовой деятельности: работа на период выполнения проекта Российского Научного Фонда. Оклад на бюджетной ставке 21 414 руб., надбавки - ежемесячно по результатам работы и в зависимости от квалификации соискателя (количество научных статей в рецензируемых изданиях за последние 2 года).

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов:

- Наличие ученой степени кандидата физико-математических наук, кандидата технических наук, кандидата химических наук (требование Российского Научного Фонда).
- Возраст не старше 35 лет по (требование Российского Научного Фонда).
- Будущий сотрудник не должен являться сотрудником ФТИ им. А.Ф. Иоффе на период 2018-2019 гг. (требование Российского Научного Фонда).
- Владение английским языком.
- Опыт работы в области физики и технологии полупроводниковых гетероструктур АЗВ5 и полупроводниковых приборов на их основе будет преимуществом.
- Наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в наукометрических базах Web of Science Core Collection и/или Scopus.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе П.Н. Брункову, телефон для справок:(812)2927196.